

In₃Te₅

1964

In₃Te₅

In₂Te₃
 In₂Te
 In₃Te₄
 In₂Te₅
 In₃Te₉

/ 6 Б657. Диаграмма состояния двойной системы индий — теллур и электрические свойства In₃Te₅. Grochowski Edward G., Mason Donald R., Schmitt Gerald A., Smith Phillip H. The phase diagram for the binary system indium—tellurium and electrical properties of In₃Te₅. «J. Phys. and Chem. Solids», 1964, 25, № 6, 551—558 (англ.)

Методами микроскопич., рентгеновского, дифференциального термич. и хим. анализов уточнялась диаграмма состояния системы In—Te и, в частности, область вблизи состава In₂Te₃. Установлено существование 2 новых фаз: In₃Te₄ (57 ат. % Te), которая распадается по перитектич. р-ции $\sim 650^\circ$, In₃Te₅ (62,5 ат. % Te), которая распадается по перитектич. р-ции при 625° и существует в 2 модификациях ζ (высокотемпературная) и ζ' (низкотемпературная) с т-рой перехода 463° . Соединение In₂Te (33,3 ат. % Te) в системе In—Te отсутствует. Соединение In₉Te₇ (43 ат. % Te) распадается по перитектич. р-ции при 462° . Соединение InTe имеет состав In₃₀Te₃₁ (50,8 ат. % Te) и плавится конгруэнтно при 696° . Соединение In₂Te₃ имеет состав In₂₇Te₄₀ (59,7 ат. % Te), плавится конгруэнтно при 667° , суще-

Б91-11-3020

2.1965.6

ствует в 2 модификациях ε и ε' с т-рой перехода $\sim 550^\circ$. Соединение In_2Te_5 (71,5 ат. % Te) имеет т-ру перитектич. превращения 467° . Измерение электрич. свойств соединения In_3Te_5 показало, что оно имеет высокую электропроводность при т-ре фазового перехода 463° ; измерения электрич. свойства In_2Te_3 , полученного зонной очисткой, не воспроизвелись. Соединение In_3Te_5 имеет гексагон. решетку с a 13,27, c 3,56 А. З. Рогачевская

в то

BP-V-3020

1964

In₃Te₅
Cu₆Te₅

The phase diagram for the binary system indium-tellurium and electrical properties of In₃Te₅. Edward G. Grochowski, Donald R. Mason, Gerald A. Schmitt, and Phillip H. Smith (Univ. of Michigan, Ann Arbor). *J. Phys. Chem. Solids* 25(6), 551-8(1964). The phase diagram for the binary system In-Te was clarified and corrected, particularly in the region near the compn. In₂Te₃. This material is a potentially important semiconductor, either alone, or in combination with other materials, such as Cu₃Te, Ag₂Te, CdTe. Results were obtained by correlating differential thermal analysis (DTA), chem. analyses of zone-refined ingots, microscopic analysis, and x-ray detns. Two new phases were identified, and the compns. of 3 other phases were detd. more precisely. The phase In₂Te (33.3 at. % Te) does not exist; the compn. should be In₉Te₇ (43 at. % Te). The peritectic decompr. temp. is 462°. The phase In₃Te (50.0 at. % Te) has the compn. In₃₀Te₃₁ (50.8 at. % Te). The congruent m.p. is 696°. A new phase In₃Te₄ (57.0 at. % Te) was found, having a peritectic decompr. temp. of 650°.

C. I. 1964 Q1 V3 25684

The phase In_2Te_3 (60.0 at. % Te) has the compn. $\text{In}_{27}\text{Te}_{40}$ (59.7 at. % Te). The congruent m.p. is 667° , and there is a phase transition at $\sim 550^\circ$. A new phase In_3Te_5 (62.5 at. % Te) was found, having a peritectic decompr. temp. of 625° , and a phase transition at 463° . The phase In_2Te_5 (71.5 at. % Te) was prep'd. Elec. measurements on In_3Te_5 show a large cond. increase assocd. with the phase transition at 463° . Elec. measurements on zone-refined In_2Te_3 were nonreproducible.

RCKH